

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年1月28日(2010.1.28)

【公開番号】特開2008-270827(P2008-270827A)

【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-044

【出願番号】特願2008-146650(P2008-146650)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/82 (2006.01)

H 0 1 L 21/822 (2006.01)

H 0 1 L 27/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/82 W

H 0 1 L 21/82 L

H 0 1 L 27/04 D

【手続補正書】

【提出日】平成21年12月7日(2009.12.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

信号配線と、

前記信号配線に対して形成された第 1 のコンタクトホールと、

前記第 1 のコンタクトホールと同一配線層内であって、前記第 1 のコンタクトホールの周囲の領域に形成されたダミーメタルと、

前記ダミーメタルに対して形成された第 2 のコンタクトホールとを備えていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記第 2 のコンタクトホールは複数設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。